

(公社)応用物理学会 先進パワー半導体研究会
第8回個別討論会「SiC基板結晶に求められるスペック」

開催期日 2013年7月19日(金)
開催場所 名古屋大学 ES総合館 ES会議室
〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町

趣旨

SiCの開発の歴史においては、基板結晶のスペック向上が常に求められてきた。そして、近年のSiCデバイスの発展をぐっとあと押しするかのよう、6インチ基板が各社から相次いで発表されている。

本討論会では、基板結晶の開発の現状をレビューしたのちに、デバイス化に必要な各技術レイヤーの課題を再確認し、それを踏まえた上で、「次世代の基板結晶に求められる真のスペックは何か」を明らかにしたい。

プログラム・内容

- (1)13:00-13:05 「趣旨説明」伊藤久義(研究会委員長/原子力機構)
- (2)13:05-13:35 「昇華法の現状と課題」藤本辰雄(新日鐵住金)
- (3)13:35-14:05 「溶液法の現状と課題」宇治原徹(名古屋大学)
- (4)14:05-14:35 「結晶加工の現状と課題」加藤智久(産総研)
- (5)14:50-15:20 「エピタキシャル成長からみた基板結晶の課題」佐藤貴幸(昭和電工)
- (6)15:20-15:50 「デバイスからみた基板結晶の課題」畠山哲夫(産総研)
- (7)15:50-16:20 会場からの話題提供
- (8)16:40-17:30 ディスカッション

参加費 1,000円
定員 50名(応募者多数の場合、抽選とさせていただきます。)
参加申込方法 下記メールアドレス宛
問合せ・申込先 〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町

名古屋大学

大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻材料工学分野

宇治原 徹

TEL 052-789-3368 FAX 052-789-3248

kobetsu8th@opt.ees.saitama-u.ac.jp

<http://annex.jsap.or.jp/scrm/>